



【1000～2000万円】 Power Device Design Senior Engineer

外資系デバイスメーカーでの募集です。電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓迎...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

外資系デバイスメーカー

Job ID

1487788

Industry

Communication

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Osaka Prefecture

Salary

10 million yen ~ 20 million yen

Work Hours

09:00 ~ 18:00

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 14日 4か月目から 【休日】完全週休二日制 土日 夏季休暇 ...

Refreshed

April 25th, 2025 10:01

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2224778】

- ・高性能パワーデバイス (SiC MOSFET/SBD, GaN HEMT, Si IGBT) のデザイン開発とテスト検証を担当し、プロセスチームと協力してデバイス加工とプロセスの最適化を行う。
- ・高性能パワーデバイス (SiC MOSFET/SBD, GaN HEMT, Si IGBT) の個別技術をフォローアップし、既存のデバイスの性能を向上させ、パテントポートフォリオを提案して実現させる。

Required Skills

必須要件

- ・半導体/電子/物理などの関連分野を専攻し、5年以上のパワーデバイスのデザイン開発経験（直近の3年間には関連のデザイン開発の従事が必須）、または優秀な博士課程の新卒者。
- ・パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の基本構造とデバイスシミュレーションデザイン方法に精通し、TCADソフトやレイアウトソフトを使用しデバイスデザインが得意な方。
- ・良好なコミュニケーション能力があり、異なる地域や異なる文化背景のチームと良好なコミュニケーションがとれる方。

Company Description

ご紹介時にご案内いたします